

4

Original document

APPARATUS AND METHOD FOR MICROWAVE PLASMA TREATMENT

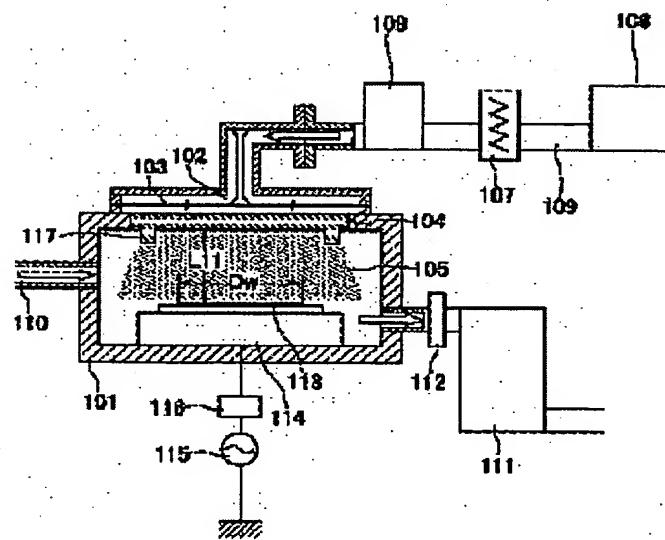
Patent number: JP2003059919
Publication date: 2003-02-28
Inventor: NAKAGAWA MASATSUGU; ISHIKAWA MICHIO
Applicant: ULVAC CORP
Classification:
- international: H01L21/31; B01J19/08; H05H1/46
- european:
Application number: JP20010248200 20010817
Priority number(s): JP20010248200 20010817

[View INPADOC patent family](#)

Abstract of JP2003059919

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an apparatus and a method for microwave plasma treatment wherein uniform plasma density is attained on the surfaces of substrates and efficient plasma treatment is performed with reliability and stability.

SOLUTION: A dielectric window which has an annular sleeve on the periphery thereof and wherein the surface shape and the thickness of the central portion thereof are adjusted in plane is used for a dielectric window placed directly above the surface of a substrate. This in-plane adjustment is made by forming stepped portions by forming projected portions in areas of the dielectric window corresponding to a specified range of the radius in the substrate, or forming recessed portions in areas corresponding to the projected portions on the surface opposite the surface on which the projected portions are formed. The thickness of the portions of the dielectric window subjected to the in-plane adjustment is approx. 1/4 of the wavelength of microwaves in the dielectric, and the portions subjected to the in-plane adjustment are discontinuously formed in the direction of the radius of the dielectric window with a diameter equivalent to an integral multiple of 1/2 the wavelength.



(51)Int.Cl.⁷H 01 L 21/31
B 01 J 19/08
H 05 H 1/46

識別記号

F I

H 01 L 21/31
B 01 J 19/08
H 05 H 1/46テ-マ-ト^{*}(参考)E 4 G 0 7 5
H 5 F 0 4 5
B

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特願2001-248200(P2001-248200)

(22)出願日

平成13年8月17日 (2001.8.17)

(71)出願人 000231464

株式会社アルパック

神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地

(72)発明者 中川 雅嗣

静岡県裾野市須山1220-1 株式会社アル

パック半導体技術研究所内

(72)発明者 石川 道夫

静岡県裾野市須山1220-1 株式会社アル

パック半導体技術研究所内

(74)代理人 100106105

弁理士 打揚 洋次 (外1名)

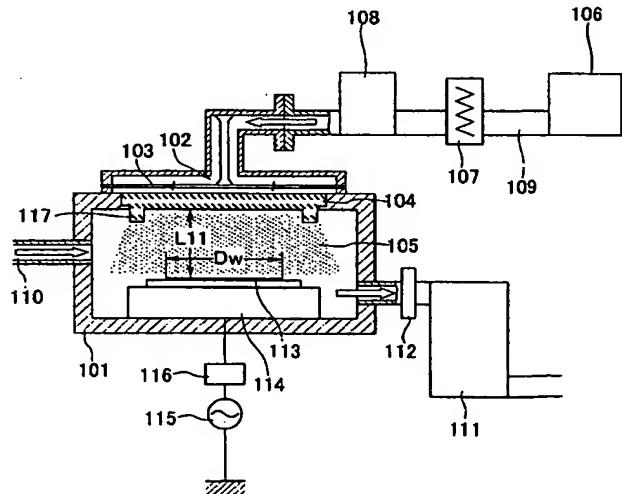
最終頁に続く

(54)【発明の名称】マイクロ波プラズマ処理装置および処理方法

(57)【要約】

【課題】 基板表面で均一なプラズマ密度を得、信頼性、安定性の高い高効率プラズマ処理を行うことができるマイクロ波プラズマ処理装置および処理方法の提供。

【解決手段】 基板表面の直上に設けられる誘電体窓として、外周部にリング状のスリーブを有し、さらに、中央部の表面形状や厚さが面内調整されたものを用いる。この面内調整は、基板内の半径の所定範囲に対応する誘電体窓の領域に凸部を設けたり、凸部の設けられた面と反対側の面の凸部対応領域に凹部を設けること等により段差を設けて行われる。誘電体窓の面内調整された領域の厚さが、誘電体内のマイクロ波の波長の1/4程度であり、また、面内調整領域が、誘電体窓の径方向に1/2波長の整数倍の直径で不連続に設けられる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】マイクロ波プラズマ処理容器内を減圧するための排気手段と、該処理容器内にプラズマを励起するためのガスを供給するためのガス供給手段と、該処理容器の壁面に設けられたマイクロ波透過用誘電体窓と、該誘電体窓のマイクロ波導入側に設けられたアンテナ手段と、該アンテナ手段の上流側に設けられたマイクロ波発生手段とを備え、該誘電体窓に対向して該処理容器内に基板が設置されるように構成されているマイクロ波プラズマ処理装置において、該基板表面の直上に設けられた該誘電体窓は、その処理容器側の面の外周部に、プラズマ励起領域が直接処理容器壁の金属表面と接触しないように、リング状のスリーブを有している事を特徴とするマイクロ波プラズマ処理装置。

【請求項2】前記基板表面の直上に設けられた誘電体窓は、さらに、その中央部の表面形状や厚さが面内調整されて、該基板内の半径の所定範囲に対応する領域がその他の領域と異なった厚さを有するように構成されている事を特徴とする請求項1記載のマイクロ波プラズマ処理装置。

【請求項3】前記基板表面の直上に設けられた誘電体窓は、さらに、その処理容器側の面およびマイクロ波導入側の面のうちの一方の面において、該基板内の半径の所定範囲に対応する領域に凸部を設けて、該基板内の半径の所定範囲に対応する領域の厚さがその他の領域の厚さより厚くなるように構成されたものであるか、または、該凸部の設けられた面と反対側の面の該凸部対応領域に凹部を設けて、該凸部と凹部との設けられた領域の厚さがその他の領域の厚さと同じになるように構成されたものである事を特徴とする請求項1記載のマイクロ波プラズマ処理装置。

【請求項4】前記基板表面の直上に設けられた誘電体窓に同心円状の段差を設けて、該基板表面から該誘電体窓の表面までの距離が基板内の半径の範囲によって異なるようにし、生成するプラズマの密度が該基板上で均一になるようにした事を特徴とする請求項1記載のマイクロ波プラズマ処理装置。

【請求項5】前記基板表面の直上に設けられた誘電体窓の同心円状の段差が、該誘電体窓の径方向に1/2波長の整数倍の直径で不連続に設けられている事を特徴とする請求項4記載のマイクロ波プラズマ処理装置。

【請求項6】前記基板表面の直上に設けられた誘電体窓が、中央部の異なった厚さを有する領域や、凸部を有する領域や、同心円状の段差を有する領域を有し、その領域の厚さが誘電体内的マイクロ波の波長の1/4程度である事を特徴とする請求項2~5のいずれかに記載のマイクロ波プラズマ処理装置。

【請求項7】マイクロ波プラズマ処理容器内にガス供給手段によってプラズマを励起するための原料ガスを供給し、排気ポンプにより原料および反応副生成ガスを排

気して容器内を減圧にし、マイクロ波発生手段により発振、增幅せしめたマイクロ波をアンテナ手段に導入してスロットを通して放射し、放射されたマイクロ波をマイクロ波透過窓を介して真空雰囲気下の該処理容器内へ導入し、このマイクロ波の作る電磁界によって処理容器内にプラズマを生成し、該誘電体窓に対向して設けられた基板をマイクロ波プラズマ処理する事からなり、該基板表面の直上に設けられた該誘電体窓として、その処理容器側の面の外周部に、プラズマ励起領域が直接処理容器壁の金属表面と接触しないように、リング状のスリーブを有しており、さらに、その中央部の表面形状や厚さが面内調整されて、該基板内の半径の所定範囲に対応する領域がその他の領域と異なった厚さを有するように構成されているか、または、その処理容器側の面およびマイクロ波導入側の面のうちの一方の面において、該基板内の半径の所定範囲に対応する領域に凸部を設けて、該基板内の半径の所定範囲に対応する領域の厚さがその他の領域の厚さより厚くなるように構成されているか、または、該凸部の設けられた面と反対側の面の該凸部対応領域に凹部を設けて、該凸部と凹部との設けられた領域の厚さがその他の領域の厚さと同じになるように構成されている誘電体窓を備えたプラズマ処理装置を用いてプラズマ処理を行う事を特徴とするマイクロ波プラズマ処理方法。

【請求項8】前記誘電体窓として、同心円状の段差を該誘電体窓の径方向に1/2波長の整数倍の直径で不連続に設けた誘電体窓を備えたプラズマ処理装置を用い、生成するプラズマの密度が基板上で均一になるようにしてプラズマ処理を行う事を特徴とする請求項7記載のマイクロ波プラズマ処理方法。

【請求項9】前記誘電体窓として、中央部の異なった厚さを有する領域や、凸部を有する領域や、同心円状の段差を有する領域を有し、その領域の厚さを誘電体内的マイクロ波の波長の1/4程度にした誘電体窓を備えたプラズマ処理装置を用いてプラズマ処理を行う事を特徴とする請求項7または8記載のマイクロ波プラズマ処理方法。

【請求項10】前記処理容器内の前記ガス圧は0.1Pa~1000Paであり、電極に印加されるマイクロ波の周波数は2GHz~10GHzであることを特徴とする請求項7~9のいずれかに記載のマイクロ波プラズマ処理方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、マイクロ波励起プラズマ処理装置（以下、マイクロ波プラズマ処理装置と称す。）およびこの装置を用いるプラズマ処理方法に係わり、特に、0.5W/cm²~20W/cm²の大電力密度のマイクロ波導入窓を有するマイクロ波プラズマ処理装置であって、半導体LSI作製における被処理物

である基板に成膜、エッチング、膜組成の改善・改質、アッシングを行うことのできるマイクロ波プラズマ処理装置、およびこの装置を用いるプラズマ処理方法に係わる。

【0002】

【従来の技術】近年、半導体LSIにおけるデバイスの微細化、ウェーハの大口径化に伴い、ウェーハの微細加工は枚葉処理が主流になっている。その中のCVDやエッチングやアッシングのプラズマ処理ではDCや高周波励起のプラズマ源が用いられている。また、マイクロ波を用いたプラズマ源ではECR(電子サイクロトロン共鳴)が用いられている。上記のように高周波やECRで励起されたプラズマの場合、高密度のプラズマを生成するためには磁場の印加が必要である上、大口径で均一なプラズマを生成することが困難であった。また、プラズマ電位が約20eVと高いために、チャンバ壁をスパッタリングして金属汚染が発生したり、さらに、フローティング基板に対するイオン照射エネルギーも10eV以上と高いために、基板にダメージを与えるといった問題もあった。

【0003】そこで、ラジアルラインスロットアンテナ(以下、RLSAと称す。)などのアンテナ手段を用い、スロットから誘電体を介してマイクロ波を真空雰囲気中に導入し、強いマイクロ波電界を作り出すことによって表面波プラズマを生成する方式が開発されている。例えば、特開2000-294548号公報には、誘電体窓の厚さを連続的に変えた方式が記載されている。この方式では、アンテナのスロットパターンにより円偏波マイクロ波を放射するので、大口径で均一なプラズマが生成でき、また、周波数が高いため、低温かつ高密度のプラズマを生成することができ、高速で良質なプラズマ処理が実現できるとされている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】前記特開2000-294548号公報記載の従来技術では、マイクロ波は、導波路を有する特定モードで伝播し、アンテナ手段から放射されて真空容器内にマイクロ波電界を作り出し、それによってプラズマを形成しているが、プラズマが高密度になると、エネルギー吸収が起こると同時にプラズマ表面でマイクロ波は反射され、不特定多数のモードが誘電体を挟んだアンテナ表面とプラズマ励起部との間で発生する。このように誘電体窓の厚さを連続的に変え、プラズマ処理室側の面を錐状にしたもの用いる場合、モードの安定性等に問題がある。

【0005】この反射波は、アンテナ表面とプラズマ励起部との間を空洞共振器として減衰されるモードと増幅されるモードとに分かれる。しかし、この反射波が、導入されたマイクロ波と干渉して減衰すると、プラズマへのパワー供給が安定せず、プラズマは不安定になる。その結果、反射波をチューナーで抑え切れなかったり、常

にオートマッチングが大きく揺れてしまい、プラズマが点滅するといった問題もあった。

【0006】また、マイクロ波は周波数が高いため、プラズマのある一部が低インピーダンスになる程、パワーがその一部に集中する傾向がある。さらに、径方向には表面波モードが形成され、これも多数のモードが結合して最も安定する状態を取るが、経時変化によりプラズマインピーダンスのバランスが少しでも崩れると、モードジャンプを起こしてプラズマ分布の再現性がとれないといった問題があった。また、この表面波モードはプロセス圧力にも大きく依存し、低圧(5~100Pa程度)と高圧(100Pa~)とではプラズマ密度分布が中央部と外周部で逆転するといった現象がある。

【0007】本発明の課題は、上記従来技術の問題を解決することにあり、基板表面で均一なプラズマ密度を得ることができ、信頼性、安定性の高い高効率プラズマ処理を行うことができるマイクロ波プラズマ処理装置およびこの装置を用いる処理方法を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明のマイクロ波励起プラズマ処理装置は、マイクロ波プラズマ処理容器内を減圧するための排気手段と、該処理容器内にプラズマを励起するためのガスを供給するためのガス供給手段と、該処理容器の壁面に設けられたマイクロ波透過用誘電体窓と、該誘電体窓のマイクロ波導入側に設けられたアンテナ手段と、該アンテナ手段の上流側に設けられたマイクロ波発生手段とを備え、該誘電体窓に対向して該処理容器内に基板が設置されるように構成されているマイクロ波プラズマ処理装置において、該基板表面の直上に設けられた該誘電体窓が、その処理容器側の面の外周部に、プラズマ励起領域が直接処理容器壁の金属表面と接触しないように、リング状のスリーブを有しているものである。

【0009】本発明のマイクロ波励起プラズマ処理装置において、基板表面の直上に設けられた誘電体窓が、さらに、その中央部の表面形状や厚さが面内調整されて、該基板内の半径の所定範囲に対応する領域が他の領域と異なった厚さを有するように構成されている事が好ましい。誘電体窓はまた、その処理容器側の面およびマイクロ波導入側の面のうちの一方の面において、該基板内の半径の所定範囲に対応する領域に凸部を設けて、該基板内の半径の所定範囲に対応する領域の厚さが他の領域の厚さより厚くなるように構成されたものであるか、または、該凸部の設けられた面と反対側の面の該凸部対応領域に凹部を設けて、該凸部と凹部との設けられた領域の厚さが他の領域の厚さと同じになるように構成されたものである事が好ましい。上記処理装置において、誘電体窓に同心円状の段差を設けて、基板表面から誘電体窓の表面までの距離が基板内の半径の範囲によって異なるようにし、生成するプラズマの密度が基板上

で均一になるようにする事が好ましい。

【0010】上記誘電体窓の同心円状の段差が、該誘電体窓の径方向に1/2波長の整数倍の直径で不連続に設けられている事が好ましい。また、誘電体窓が、中央部の異なる厚さを有する領域や、凸部を有する領域や、同心円状の段差を有する領域を有し、その領域の厚さが誘電体内のマイクロ波の波長の1/4程度である事が好ましい。本発明のマイクロ波プラズマ処理装置によれば、大口径の誘電体窓、例えば、直径250mm以上を有するか、または直径250mmの円と同等以上の面積を有する誘電体窓を用い、大電力密度のマイクロ波を導入する事が可能である。

【0011】本発明のマイクロ波プラズマ処理方法は、マイクロ波プラズマ処理容器内にガス供給手段によってプラズマを励起するための原料ガスを供給し、排気ポンプにより原料および反応副生成ガスを排気して容器内を減圧にし、マイクロ波発生手段により発振、增幅せしめたマイクロ波をアンテナ手段に導入してスロットを通して放射し、放射されたマイクロ波をマイクロ波透過窓を介して真空雰囲気下の該処理容器内へ導入し、このマイクロ波の作る電磁界によって処理容器内にプラズマを生成し、該誘電体窓に対向して設けられた基板をマイクロ波プラズマ処理する事からなり、上記したように構成された誘電体窓を備えたプラズマ処理装置を用いてプラズマ処理する。上記処理容器内のガス圧は0.1Pa~1000Paであり、電極に印加されるマイクロ波の周波数は2GHz~10GHzである事が好ましい。ガス圧が0.1Pa未満であり、また、1000Paを超えると放電開始及び維持が困難となる。また、周波数が2GHz未満であると所望のプラズマ密度が得られず、10GHzを超えると電力增幅のための設備が大がかりになるほか、その取り扱いに難がある。

【0012】本発明によれば、マイクロ波プラズマ処理装置において、上記したように誘電体窓の表面形状や厚さを面内調整し、供給するマイクロ波と反射波が共振器内で増幅される領域とそうでない領域とを形成する事で、パワーをその増幅される領域に効率的に集中させ、また、空間で安定する表面波モードを制限する事でモードジャンプの発生を抑制できるため、信頼性、安定性の高い高効率プロセスを行うことができる。また、プラズマは、誘電体窓の表面から僅か数ミリ以内離れた領域で励起され、拡散によって対向する基板上に到達する。この拡散によるプラズマ密度の減衰は略々距離の二乗に比例する。プラズマ密度の低い領域に対応する誘電体部分を基板側に近づけるように誘電体窓の形状に段差をつける事により、基板表面で均一なプラズマ密度を得る事が出来る。

【0013】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態に係るマイクロ波プラズマ処理装置を、図1、2、5、および

6を参照して説明する。図1は、本発明の第一実施態様として、RLSAを用いた半導体基板用マイクロ波プラズマ処理装置において、外周部にリング状のスリーブを有するマイクロ波透過窓を備えた装置の概略の構成を示す断面図である。

【0014】図1において、101はプラズマ処理を行うための処理容器、102は同軸導波変換器およびアンテナ手段、103はマイクロ波を放射するスロット、104はマイクロ波透過用誘電体窓、105はエッチングや成膜を行うために基板上方にマイクロ波電界により形成されたプラズマ、106はマイクロ波を発振するマグネットロン、107はアイソレータ、108は4Eチューナー、109は導波管、110はプラズマ形成用ガスの供給手段、111は排気ポンプ、112は容器101内の圧力を調整する圧力調整弁、113はプラズマ処理をされる基板、114は基板を保持する電極、115は基板電極114および基板113に必要に応じて高周波を印加するための高周波電源、116は高周波のインピーダンス調整をとるための整合器である。誘電体窓104の外周部、すなわち中央部から離れた部分には、プラズマ励起領域が直接処理容器壁の金属表面と接触しないようリング状のスリーブ117が形成されている。

【0015】以下、図1に示す装置を用いて行うプラズマ処理方法についての概要を説明する。処理容器101内にガス供給手段110によってプラズマ105を励起させるためのガスを供給し、排気ポンプ111を作動させ、原料および反応副生成ガスを排気して処理容器101内を減圧にし、処理容器101内のプロセス圧力を圧力調整弁112によって調整する。マグネットロン106で発振、增幅されたマイクロ波は4Eチューナー108を通してアンテナ102に導入され、スロット103から放射される。このとき、反射波は4Eチューナー108によって処理容器101側へと戻されるが、調整しきれない反射波についてはアイソレータ107で吸収し、マグネットロン106へ戻ることを防いでいる。スロット103から放射されたマイクロ波は誘電体窓104を介して真空雰囲気下の処理容器101の内部へ導入され、このマイクロ波の作る電磁界によって処理容器101内にプラズマ105を形成する。

【0016】形成されたプラズマ105の密度が誘電体窓104の近傍でマイクロ波のカットオフ密度を越えると、マイクロ波の侵入長は数ミリとなってプラズマ中の数ミリの範囲において一部のエネルギーがプラズマ105に吸収され残りは反射される。生成されたプラズマ105の密度分布は、スロットパターンによっては平面で均一に調整することができるが、その時の処理容器101内の圧力や誘電体窓104の形状にも大きく依存する。このようにして生成されたプラズマ105は拡散によって基板113へ到達し、基板113に対して所望の50 プラズマ処理を施すことができる。

【0017】図2は、本発明の第二実施態様として、RLSAを用いた半導体基板用マイクロ波プラズマ処理装置の構成において、アンテナ手段側の面に凸部を設けたマイクロ波透過窓を備えた装置の概略の構成を示す断面図である。この装置においては、マイクロ波の導入窓を構成する誘電体窓204として、同心円の領域、すなわち、円形の誘電体窓の中心から所定の等距離までの領域において大気側（マイクロ波導入側）の表面に凸部（直径：D2）を設けて、その部分の厚さを変えた誘電体窓を用いている。その他の構成は図1に示すものと同じ構成であり、図中の符号については、特に断らない限り、図1と同じ符号は同じ構成を示す。

【0018】マイクロ波の導入窓である誘電体窓204は、誘電体窓104と同様の材質のものから作製され得る。厚さ50mmの石英板を用いる場合、例えば、 $\phi = 95\text{ mm}$ までの範囲（D2）の領域において誘電体窓204の大気側を凸型にし、その凸型部分の厚さを60mmにしてある。例えば、直径（Dw）200mmのシリコン基板の直上にある誘電体窓の厚さは、基板の半径が0mmから47.5mmまでの範囲（D2 X 1/2）の領域においてその直上に位置する領域の厚さが60mmになり、他の領域における厚さが50mmになる。

【0019】図5は、本発明の第三実施態様として、RLSAを用いた半導体基板用マイクロ波プラズマ処理装置の構成において、処理容器101側の面に凸部を設けたマイクロ波透過窓を備えた装置の概略の構成を示す断面図である。この装置においては、マイクロ波の導入窓を構成する誘電体窓504として、同心円の領域、すなわち誘電体窓の中心から所定の等距離までの領域において図2の場合とは逆に真空側の表面に凸部（直径：D5）を設けて、その部分の厚さを変えた誘電体窓を用いている。その他の構成は図1に示すものと同じ構成であり、図中の符号については、特に断らない限り、図1と同じ符号は同じ構成を示す。

【0020】マイクロ波の導入窓である誘電体窓504は、誘電体窓104と同様の材質のものから作製され得る。厚さ44mmの石英板を用いる場合、例えば、 $\phi = 60\text{ mm}$ までの範囲（D5）の領域において誘電体窓504の真空側を凸型にし、その凸型部分の厚さを60mmにしてある。例えば、直径（Dw）200mmのシリコン基板の直上にある誘電体窓の厚さは、基板の半径が0mmから30mmまでの範囲（D5 X 1/2）の領域においてその直上に位置する領域の厚さが60mmになり、他の領域における厚さが44mmになる。また、基板の半径が0mmから30mmまでの領域（D5 X 1/2）において、基板から誘電体板までの距離（L52）を40mmとし、他の領域においてはその距離（L51）を56mmとしてある。

【0021】図6は、本発明の第四実施態様として、RLSAを用いた半導体基板用マイクロ波プラズマ処理装

10

置の構成において、処理容器101側の面に凸部を設け、かつ、大気側の面で該凸部に対応する領域に凹部を設けたマイクロ波透過窓を備えた装置の概略の構成を示す断面図である。この装置においては、マイクロ波の導入窓を構成する誘電体窓604として、同心円の領域、すなわち誘電体窓の中心から所定の等距離までの領域においてマイクロ波導入側の表面に凸部、真空側の表面に凹部を設けるように加工し、誘電体窓自体の厚さがどの領域においても同じ厚さになるように構成した誘電体窓を用いている。その他の構成は図1に示すものと同じ構成であり、図中の符号については、特に断らない限り、図1と同じ符号は同じ構成を示す。

20

【0022】マイクロ波の導入窓である誘電体窓604は、誘電体窓104と同様の材質のものから作製され得る。厚さ50mmの石英板を用いる場合、例えば、 $\phi = 60\text{ mm}$ までの範囲（D6）の領域において誘電体窓604の真空側を凹型にし、基板613から直径（Dw）200mmの基板の直上にある誘電体窓までの距離については、基板の半径が0mmから30mmまでの範囲（D6）の領域においてはその距離（L62）を65mmとし、他の領域においてはその距離（L61）を60mmとしてある。上記プラズマ処理容器内の圧力は、プロセス条件により異なるが、一般に、5Pa～1000Paの範囲において所望の効果を得ることができる。誘電体窓の下面と基板の上面との距離（L11、L21、L51、L52、L61、L62）は、プラズマ密度、酸化速度、膜厚分布均一性等の関係により、一般に、30mm～120mmの範囲にすることが好ましい。

30

【0023】上記したように誘電体窓の厚さを所定の範囲内で変える場合は、その厚さを誘電体内のマイクロ波の波長（ λ_g ）の $\lambda_g/4$ 程度にする事が望ましい。マイクロ波の電界強度はそこに存在する定在波の状況により交播するので、中央部が最適厚さであれば、薄い外周部ではプラズマ密度が低くなってしまう。これは、誘電体窓の厚さを単に部分的に薄くしただけではその薄い部分で電界強度が強くなるとは限らないからである。そのため、本発明におけるように、中央部の厚さを規定して、誘電体内のマイクロ波の波長の $\lambda_g/4$ の段差を設けることが効果的である。誘電体窓の厚さを変える範囲または段差をつける範囲は、同心円のリング状に配置されたものであっても、または適宜分布させて配置されたものでも良い。

40

【0024】高密度のプラズマを生成するためには、投入するマイクロ波の周波数を、一般に、2GHz～10GHzの範囲内から適宜選択し、また、誘電体窓の直下のプラズマ密度がマイクロ波のカットオフ密度に達するようにするためには、投入電力を、誘電体窓下面の面積に対して、好ましくは 1 W/cm^2 ～ 5 W/cm^2 の範囲内から適宜選択してプロセスを行うのがよい。プロセ

50

スガスとしては、堆積膜（絶縁膜、半導体膜、金属膜等）の形成、CVD法による薄膜（シリコン系半導体薄膜、シリコン化合物系薄膜、金属薄膜、金属化合物薄膜等）の形成、基板表面のエッチング、基板表面上の有機成分のアッショング除去、基板表面の酸化処理、基板表面の有機物のクリーニング等の各プロセスによって異なるが、公知の各種ガスを適宜選択して用いることができる。例えば、一種類以上の公知のガスをプロセス中に少なくとも合計 $8.5 \times 10^{-2} \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{sec}$ 以上導入すればよい。

【0025】基板の支持ステージ温度は、エッチングや成膜等の各プロセスによって異なるが、一般に、-40℃～600℃の範囲内から適宜選択すればよい。処理対象とする基板は、特に制限されず、例えば、半導体基板に限らず、ガラス基板、プラスチック基板、AlTiC基板等を使用できる。マイクロ波の導入窓を構成する誘電体としては、機械的強度が十分で、マイクロ波の透過率が十分高くなるように誘電損失が非常に小さい材料であれば特に制限されず、例えば、石英、アルミナ（サファイア）、窒化アルミニウム、窒化シリコン、フッ化炭素ポリマー等を用いることができる。

【0026】

【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照してさらに詳細に説明する。

（実施例1）図1および図2に示す本発明の装置を用いてKr/O₂プラズマを生成し、シリコン基板を直接酸化処理した後の処理ウェーハの酸化膜の厚さの測定について説明する。はじめに、図1に示す装置を用いて行うシリコン基板の酸化処理について説明する。マイクロ波の導入窓に誘電体窓104を設置し、シリコン基板113を真空処理容器101内にセットした後、マグネットロン106からマイクロ波を出力して下記の条件でプラズマを生成し、プラズマ酸化後のシリコン基板113の酸化膜の厚さをエリプソメータにより測定した。

【0027】誘電体窓104として、直径380mm（真空容器側：350mm）、厚さ50mmの石英板（誘電率3.8、誘電損失<1.0×10⁻⁴ @ 2.45GHz）を設置した。マイクロ波は周波数：2.45GHzで出力：2.5kW（約2.6W/cm²）とし、ホットプレート温度を400℃に維持し、シリコン基板113の上面と誘電体窓104の下面との間の距離（L11）を60mmとして、基板電極114上にあるシリコン基板113には高周波バイアスを印加することなく、プラズマ処理を行った。プラズマ励起用ガスとして、Krを0.5Pa·m³/sec、O₂を1.7×10⁻²Pa·m³/sec供給し、圧力調整弁112によって処理容器101内の圧力を133Paに調整し、10分間放電して、ウェーハのプラズマ酸化処理を行った。また、圧力調整弁112によって処理容器101内の圧力を80Paに調整したこと以外は、上記と同

じ条件でプラズマ処理を行った。

【0028】その結果、基板上に形成されたシリコン酸化膜の厚さの分布はほぼ同心円状となった。図3にその径方向の平均厚さを示す。図3から、80Paの場合には、基板上の外周部が中央部よりも膜厚が厚く、酸化速度が速いのに対し、133Paの場合は、中央部の酸化速度の方が速いという事がわかる。

【0029】次に、図2に示す装置を用いて、図1に示す装置の場合と同様の条件で、シリコン基板213をプラズマ酸化処理し、酸化膜（酸化シリコン膜）の厚さを

10 エリプソメータにより測定した。その結果、基板上に形成されたシリコン酸化膜の厚さの分布はほぼ同心円状に均一となった。図4にその径方向の平均厚さを示す。この結果を図3と比較すると、80Paの場合の酸化膜の膜厚分布から、外周部は依然中央部よりも酸化速度は速いがその差違は小さくなっている。また、分布均一性が改善されていることがわかる。また、全体的に酸化膜の形成速度が速くなっている。このことから、誘電体窓の形状を変更する事でマイクロ波のパワーが効率的にプラズマに供給されるようになるとともに、分布均一性が向上している事がわかる。133Paの場合も、全体的に酸化速度が速くなっている。80Paの場合と同様のことといえる。

【0030】（実施例2）図5に示す装置を用いてKr/O₂プラズマを生成し、シリコン基板を直接酸化処理した後の処理ウェーハの酸化膜の厚さの測定について説明する。実施例1に記載した図1に示す装置の場合と同様の条件で、シリコン基板513をプラズマ酸化処理し、酸化膜の厚さをエリプソメータにより測定した。

30 【0031】その結果、基板上に形成されたシリコン酸化膜の厚さの分布はほぼ同心円状に均一となった。図7にその径方向の平均厚さを示す。この結果を図3と比較すると、80Paの場合の酸化膜の膜厚分布から、図3の場合と逆に中央部が外周部よりも酸化速度が速くなっていることがわかる。これは、シリコン基板の半径が0mmから30mmまでの範囲において、誘電体窓（プラズマ生成領域）までの距離（L52）が短いために基板に到達するプラズマの密度が他の範囲（距離：L51）より高いためである。よって、領域ごとに真空側の誘電体窓下面から基板までの距離を近づける事でその領域での成膜速度が上昇し、また、その距離を調整する事で膜厚の分布均一性を改善する事が出来る。

【0032】（実施例3）図6に示す装置を用いてKr/O₂プラズマを生成し、シリコン基板を直接酸化処理した後の処理ウェーハの酸化膜の厚さの測定について説明する。実施例1に記載した図1に示す装置の場合と同様の条件で、シリコン基板613をプラズマ酸化処理し、酸化膜の厚さをエリプソメータにより測定した。

【0033】その結果、基板上に形成されたシリコン酸化膜の厚さの分布はほぼ同心円状に均一となった。図8

にその径方向の平均厚さを示す。この結果を図3と比較すると、80Paの場合の酸化膜の膜厚分布から、中央部の酸化速度が上昇する方向に改善され、また、均一性が上がっている事がわかる。一方、133Paにおいては逆に外周部の酸化速度が上昇する方向に改善され、また、均一性が上がっている。これは、一見、上記実施例の結果と矛盾するが、133Paの高圧条件においては平面形状の誘電体窓104(図1)を用いてもプラズマが中央部に集中する傾向がある。しかし、実施例2における結果のように基板中央部は誘電体窓(プラズマ生成領域)までの距離(L62)が他の領域(距離:L61)に比べて5mm遠いため、基板に到達するプラズマの密度が他の範囲より薄くなり、分布が改善されたと考えられる。逆に、80Paの低圧ではプラズマ密度が薄いためにプラズマは広がる傾向があるが、表面波の発生する面の一部を凹型にすることで凹型の領域でのプラズマ生成が多くなり、マイクロ波の安定結合モードが圧力条件により影響を受け難くなつたためと考えられる。そのため、プラズマの広がりが抑えられ、高圧条件の場合に近い分布が得られるようになったのである。

【0034】上記の様に、領域ごとに誘電体窓の両面に凹凸加工を施す事で、この領域にマイクロ波のパワーを意図的に集中させ、圧力依存が少なくかつ均一性の良いプラズマの生成が可能になった。上記実施例では、図1、2、5および6に示すマイクロ波プラズマ処理装置を用いて、シリコン基板をプラズマ酸化処理し、酸化膜を形成したが、同じプラズマ処理装置を用いて、半導体LSI作製における被処理物である基板に対して、成膜、エッチング、膜組成の改善・改質、アッシング等の工程を、公知の薄膜形成ガス、エッチャントガス、アッシングガス等を用いて行う事ができた。

【0035】

【発明の効果】以上詳細に説明したように、本発明によれば、マイクロ波プラズマ処理装置において、誘電体窓の表面形状や誘電体窓の厚さを面内調整し、供給するマイクロ波と反射波が共振器内で増幅される領域とそうでない領域を形成する事で、パワーをその増幅される領域に効率的に集中させることができるため、また、空間で安定する表面波モードを制限する事でモードジャンプの発生を抑制できるため、信頼性、安定性の高い高効率プロセスを行うことができる。また、プラズマは誘電体窓から数ミリ以内の領域で励起され、拡散によって対向する基板上に到達する。この拡散によるプラズマ密度の減衰は略々距離の二乗に比例する。密度の低い領域の誘電体窓を基板側に近づくように段差をつける事により基板表面で均一なプラズマ密度を得る事が出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第一実施形態に係るマイクロ波プラズマ処理装置の概略の構成を示す模式的断面図。

【図2】 本発明の第二実施形態に係るマイクロ波プラズマ処理装置の概略の構成を示す模式的断面図。

【図3】 図1に示す装置を用いて形成されたシリコン酸化膜について、その径方向の平均厚さを示すグラフ。

【図4】 図2に示す装置を用いて形成されたシリコン酸化膜について、その径方向の平均厚さを示すグラフ。

【図5】 本発明の第三実施形態に係るマイクロ波プラズマ処理装置の概略の構成を示す模式的断面図。

【図6】 本発明の第四実施形態に係るマイクロ波プラズマ処理装置の概略の構成を示す模式的断面図。

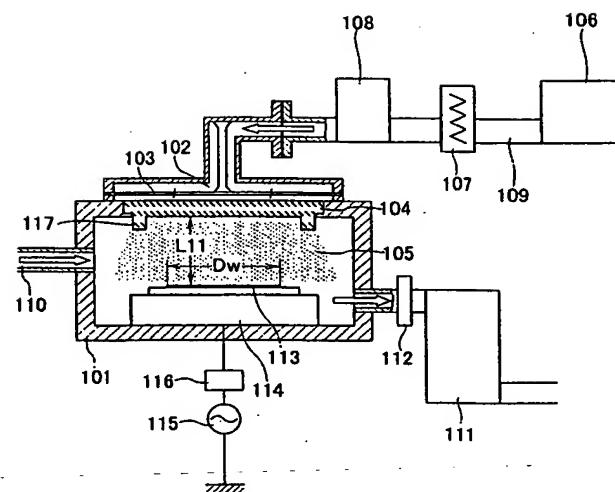
【図7】 図5に示す装置を用いて形成されたシリコン酸化膜について、その径方向の平均厚さを示すグラフ。

【図8】 図6に示す装置を用いて形成されたシリコン酸化膜について、その径方向の平均厚さを示すグラフ。

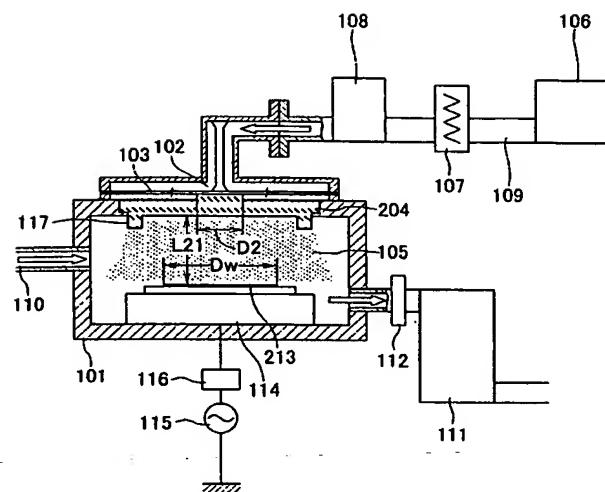
【符号の説明】

101	プラズマ処理容器	102	同軸導波変換器およびアンテナ
20	103 スロット	104	誘電体板
	105 プラズマトロン	106	マグネットロン
	107 アイソレータ	108	4Eチューナー
	109 導波管	110	ガス供給手段
	111 排気ポンプ	112	圧力調整弁
30	113 基板	114	基板電極
	115 基板電極用高周波電源	116	基板電極用整合器
	117 スリーブ	204	誘電体板
	213 基板	211	誘電体板-基板間距離
	Dw 基板範囲	D2	誘電体板厚さ変更範囲
40	504 誘電体板	513	基板
	L51 誘電体板-基板間距離	L52	誘電体板-基板間距離(厚さ変更部)
	D5 誘電体板厚さ変更範囲		
	604 誘電体板	613	基板
	L61 誘電体板-基板間距離	L62	誘電体板-基板間距離(形状変更部)
	D6 誘電体厚さ変更範囲		

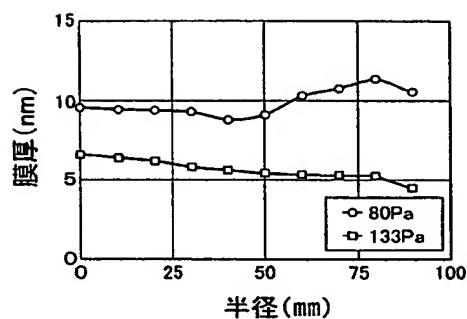
【図1】



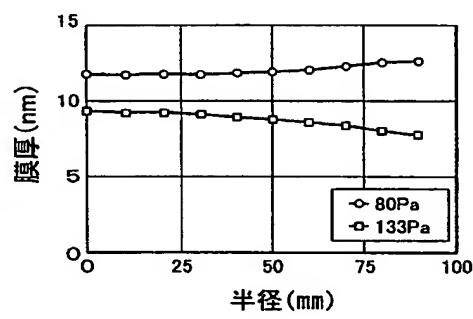
【図2】



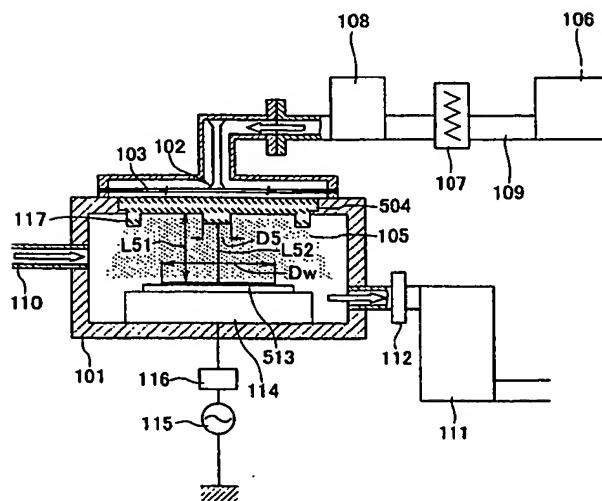
【図3】



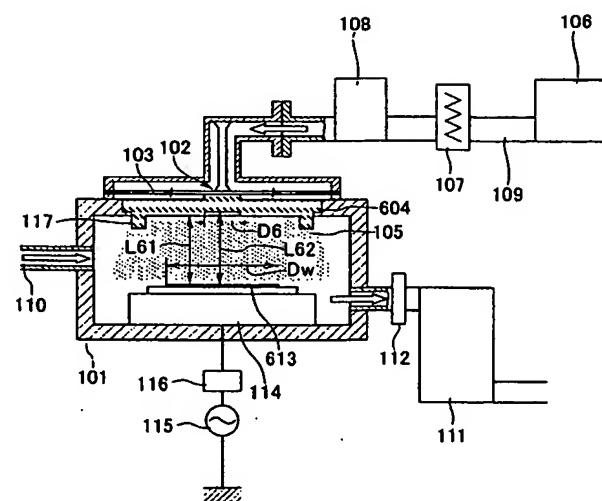
【図4】



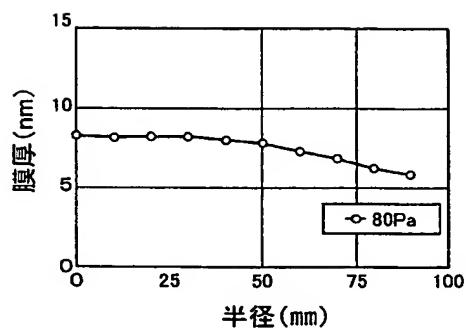
【図5】



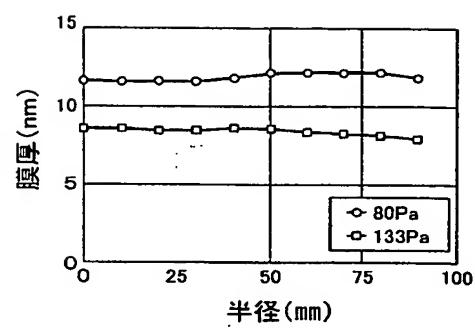
【図6】



【図7】



【図8】



フロントページの続き

F ターム(参考) 4G075 AA24 AA30 BC01 BC06 CA26
 EC30 EE02 FA05 FC15
 5F045 AA20 AB32 AC11 AC14 AD08
 AE19 AE21 AF03 BB02 DP04
 EH03 EH11 EH20 GB13